

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления	
Исаева А.А., Смагин В.П. Фотолюминесценция квантовых точек (Zn, Pb, Mn)S в полиакрилатной матрице	435
Ширяев А.А., Воротынцев В.М., Шоболов Е.Л. Прогнозирование величины захваченного заряда в захороненном оксиде кремния структур кремний-на-изоляторе с применением эффекта Пула-Френкеля	441
Давыдов С.Ю. Низкоразмерные структуры карбида кремния: аналитические оценки характеристик электронного спектра	446
Слипченко С.О., Подоскин А.А., Соболева О.С., Юферев В.С., Головин В.С., Гаврина П.С., Романович Д.Н., Мирошников И.В., Пихтин Н.А. Исследования процессов транспорта носителей заряда в изотипных гетероструктурах типа n^+-GaAs/n^0-GaAs/n^+-GaAs с тонким широкозонным барьером AlGaAs	452
Trir H., Radjhi L., Sengouga N., Tibermacine T., Arab L., Filali W., Abdelkader D., Attaf N. Effect of Annealing on the Dark and Illuminated I(V) Characterization of a ZnO : Ga Cu₂O Hetero-junction Prepared by Ultrasonic Spray System	458
Botzakaki M.A., Skoulatakis G., Papageorgiou G.P., Krontiras C.A. Interfacial Characterization and Transport Conduction Mechanisms in Al HfO₂ p-Ge Structures: Energy Band Diagram	459
Sailai M., Aierken A., Qiqi L., Heini M., Zhao X., Mo J., Jie Guo, Hao R., Yu Z., Qi G. Effects of 1-MeV Electron Irradiation on the Photoluminescence of GaInNAs GaAs Single Quantum Well Structure	460
Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники	
Кононов А.А., Кастро Арата Р.А., Главная Д.Д., Стожаров В.М., Долгинцев Д.М., Сайто Ю., Фонс П., Анисимова Н.И., Колобов А.В. Поляризационные процессы в тонких слоях аморфного MoS₂, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления	461
Физика полупроводниковых приборов	
Маматкаримов О.О., Химматкулов О., Турсунов И.Г. Влияние одноосной упругой деформации на вольт-амперную характеристику поверхностно-барьерных диодов Sb-p-Si<Mn>-Au	466
Тандоев А.Г., Мнацаканов Т.Т., Юрков С.Н. S-образные вольт-амперные характеристики мощных диодов Шоттки при больших плотностях тока	470
Соболева О.С., Головин В.С., Юферев В.С., Гаврина П.С., Пихтин Н.А., Слипченко С.О., Подоскин А.А. Моделирование пространственной динамики включения лазера-тиристора ($\lambda=905$ нм) на основе многопереходной гетероструктуры AlGaAs/InGaAs/GaAs	478
Подоскин А.А., Романович Д.Н., Шашкин И.С., Гаврина П.С., Соколова З.Н., Слипченко С.О., Пихтин Н.А. Модель управления конкуренцией замкнутых модовых структур в прямоугольных резонаторах большого размера на основе лазерных гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs	484

Kim J., Kim K.

A Novel 4H-SiC Super Junction UMOSFET with Heterojunction Diode for Enhanced Reverse Recovery Characteristics and Low Switching Loss

490

Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Середин П.В., Голощапов Д.Л., Золотухин Д.С., Леньшин А.С., Худяков Ю.Ю., Мизеров А.М., Тимошнев С.Н., Арсентьев И.Н., Бельтюков А.Н., Leiste Harald, Кукушкин С.А.

Влияние слоя нанопористого кремния на практическую реализацию и особенности эпитаксиального роста слоев GaN на темплейтах SiC/por-Si/c-Si

491

Болотов В.В., Ивлев К.Е., Князев Е.В., Пономарева И.В., Росликов В.Е.

Формирование многослойных структур с интегрированными мембранами на основе пористого кремния

504